



2SB1424 (3CG1424)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于一般放大。

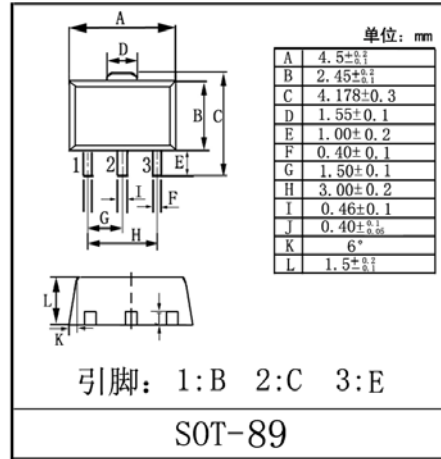
Purpose: General purpose amplifier.

特点:饱和压降低, 极好的直流电流增益特性好。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, excellent DC current gain characteristics.

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-20	V
V_{CE0}	-20	V
V_{EB0}	-6.0	V
I_C	-3.0	A
I_{CP}	-5.0	A
P_C	0.6	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



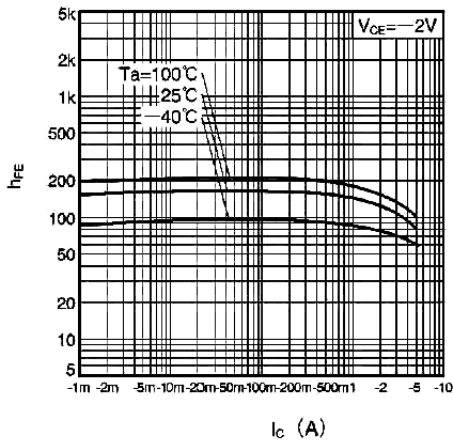
电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-50\mu\text{A}$	$I_E=0$	-20			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$	$I_B=0$	-20			V
V_{EB0}	$I_E=-50\mu\text{A}$	$I_C=0$	-6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-20\text{V}$	$I_E=0$			-0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$	$I_C=0$			-0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-2.0\text{V}$	$I_C=-0.1\text{A}$	120		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-2.0\text{A}$	$I_B=-0.1\text{A}$			-0.5	V
f_T	$V_{CE}=-2.0\text{V}$	$I_C=-0.5\text{A}$		240		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$	$I_E=0$		35		pF

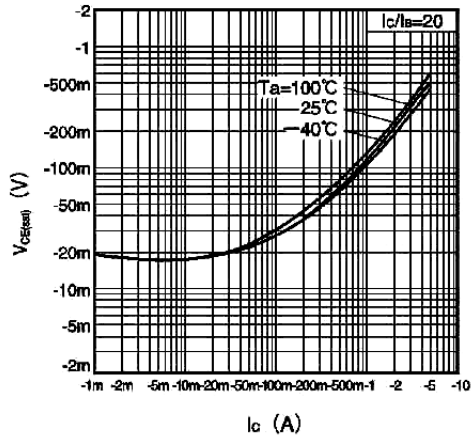
h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档/ h_{FE} Classifications	Q	R
h_{FE} 范围/ h_{FE} Range	120~270	180~390
印章/Marking	HAEQ *	HAER *

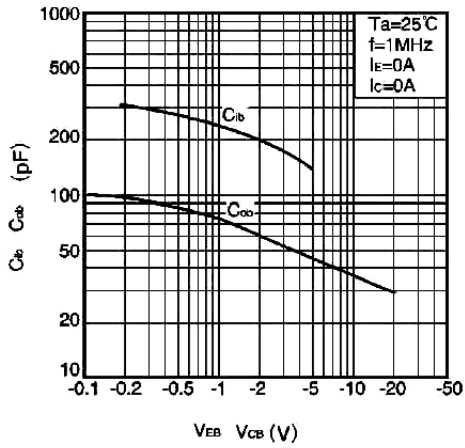
$h_{FE} - I_C$



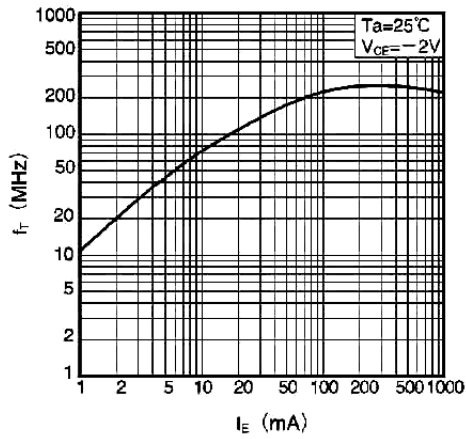
$V_{CE(sat)} - I_C$



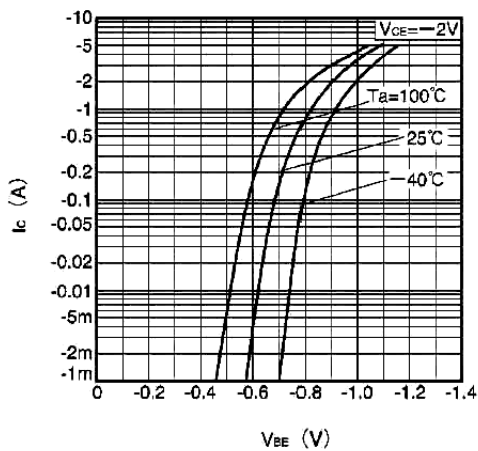
$C_{ib} C_{ob} - V_{EB} V_{CE}$



$f_T - I_E$



$I_C - V_{BE}$



$I_C - V_{CE}$

